

12月9日(水) (Wednesday 9 December)**オープニング 9:55~10:00【第1会場】**

9:55~10:00 開会挨拶
幹事長 須田 淳(名古屋大学)

セッションI: 基調講演 10:00~11:30【第1会場】

10:00~10:45 ホンダの電動化モビリティ紹介とパワー半導体技術への期待
【基調講演】
Introducing Honda's electrified mobility and expectations for power semiconductor technology

篠原 貞夫(本田技術研究所)

10:45~11:30 宇宙線破壊耐圧が示すワイドバンドギャップ半導体パワーデバイスの余力
【基調講演】
Potential of Wide-Bandgap Semiconductor Power-Devices Suggested by Their Breakdown Voltages Under Cosmic-Ray Exposure
○小林大輔¹, 張惠^{1,2}, 山本知之², 廣瀬和之^{1,2}(1.宇宙航空研究開発機構, 2.早稲田大学)

インダストリアルセッション 11:35~12:15【第1会場】

11:35~12:15 インダストリアルセッション

(昼食休憩 12:15~13:00)

セッションII: 招待講演 13:00~15:00【第1会場】

13:00~13:30 SiC-MOSFETモジュールの850V 100kW 双方向絶縁形DC-DCコンバータへの応用
【招待講演】
Application of SiC-MOSFET Modules to 850-V 100-kW Bidirectional Isolated DC-DC Converters

赤木 泰文(東京工業大学)

13:30~14:00 kV・kA級ハイブリッド直流遮断器のためのアークフリー転流
【招待講演】
Arc-Free commutation for kV/kA hybrid DC Circuit Breaker

安岡 康一(東京工業大学)

14:00~14:30 SiC-MOSFET インバータを用いた高周波誘導加熱方式小金属検出
【招待講演】
Small-Foreign-Metal Particles Detection Based on High-Frequency Induction Heating Using an SiC-MOSFET Inverter

○田中 俊彦, 山田 洋明(山口大学)

14:30~15:00 ニッケルマイクロメッキ接合によるSiCパワーモジュールの高耐熱実装技術
【招待講演】
High-temperature resistnat packaging for SiC power module using interconnections formed by Ni micro-electroplating

巽 宏平(早稲田大学)

(休憩: 15:00~15:30)

ポスターセッションI 15:30~17:30【ポスター会場】

15:30~16:30 前半(IA)

16:30~17:30 後半(IB)